



Двухпозиционный Диодный Модуль МДх-1000-28-D

Изолированное основание
Корпус промышленного стандарта
Упрощенная механическая конструкция,
быстрая сборка
Прижимная конструкция

Средний прямой ток			I_{FAV}	1000 A	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U_{RRM}	2000...2800 В	
U_{RRM} , В	2000	2200	2400	2600	2800
Класс по напряжению	20	22	24	26	28
T_j , °C	-40...+150				

МД3	МД4	МД5
<p>Dimensions (mm / inches):</p> <ul style="list-style-type: none"> Top view: 5 (0,197), 15 (0,59), 60 (2,362), 60 (2,362) Side view: 74 (2,913), 25 (0,984), 20 (0,787), 84 (3,307) Front view: 40 (1,574), 132 (5,196), 150 (5,9), 180 (7,087), 58 (2,283), 77 (3,031) Other: $\phi 8,5$ (0,335) DIA 4 apertures, M12, $\phi 25$ (0,984) 		


ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток	A	1000 885	$T_c=91\text{ }^\circ\text{C}$; $T_c=100\text{ }^\circ\text{C}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток	A	1570	$T_c=91\text{ }^\circ\text{C}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток	кА	32.0 37.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
			34.0 39.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
I^2t	Защитный показатель	$A^2c\cdot 10^3$	5100 6800	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
			4700 6300	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	B	2000...2800	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	B	2100...2900	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	B	$0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j=T_{j\max}$;	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	$^\circ\text{C}$	-40...+50		
T_j	Температура р-п перехода	$^\circ\text{C}$	-40...+150		
$T_{c\text{оп}}$	Рабочая температура корпуса	$^\circ\text{C}$	-40...+125		
Механические параметры					
a	Ускорение	$\text{м}/\text{с}^2$	50		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	B	1.38	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_{FM}=3140\text{ A}$	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	B	0.80	$T_j=T_{j\max}$;	
r_T	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.150	$0.5 \pi I_{FAV} < I_T < 1.5 \pi I_{FAV}$	
Блокирующие характеристики					
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	70 4.00	$T_j=T_{j\max}$; $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	$U_R=U_{RRM}$
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц	
	на модуль	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0250		
	на позицию	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0500		
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц	
	на модуль	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0080		
	на позицию	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0160		

Характеристики изоляции					
U _{ISOL}	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	t=60 с
			3.60		t=1 с
Механические характеристики					
M ₁	Момент затяжки основания (M8) ¹⁾	Нм	9.00	Допуск ± 15%	
M ₂	Момент затяжки выводов (M12) ¹⁾	Нм	18.00	Допуск ± 15%	
m	Масса, макс	г	4100		

МАРКИРОВКА						ПРИМЕЧАНИЕ				
МД	3	-	1000	-	28	-	D	-	У2	¹⁾ Резьба должна быть смазана
1	2		3		4		5		6	
1. МД – Диодный Модуль 2. Схема включения 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению 5. Тип корпуса (М.х) 6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2										
 Сертифицирован UL, файл № E255404										

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.

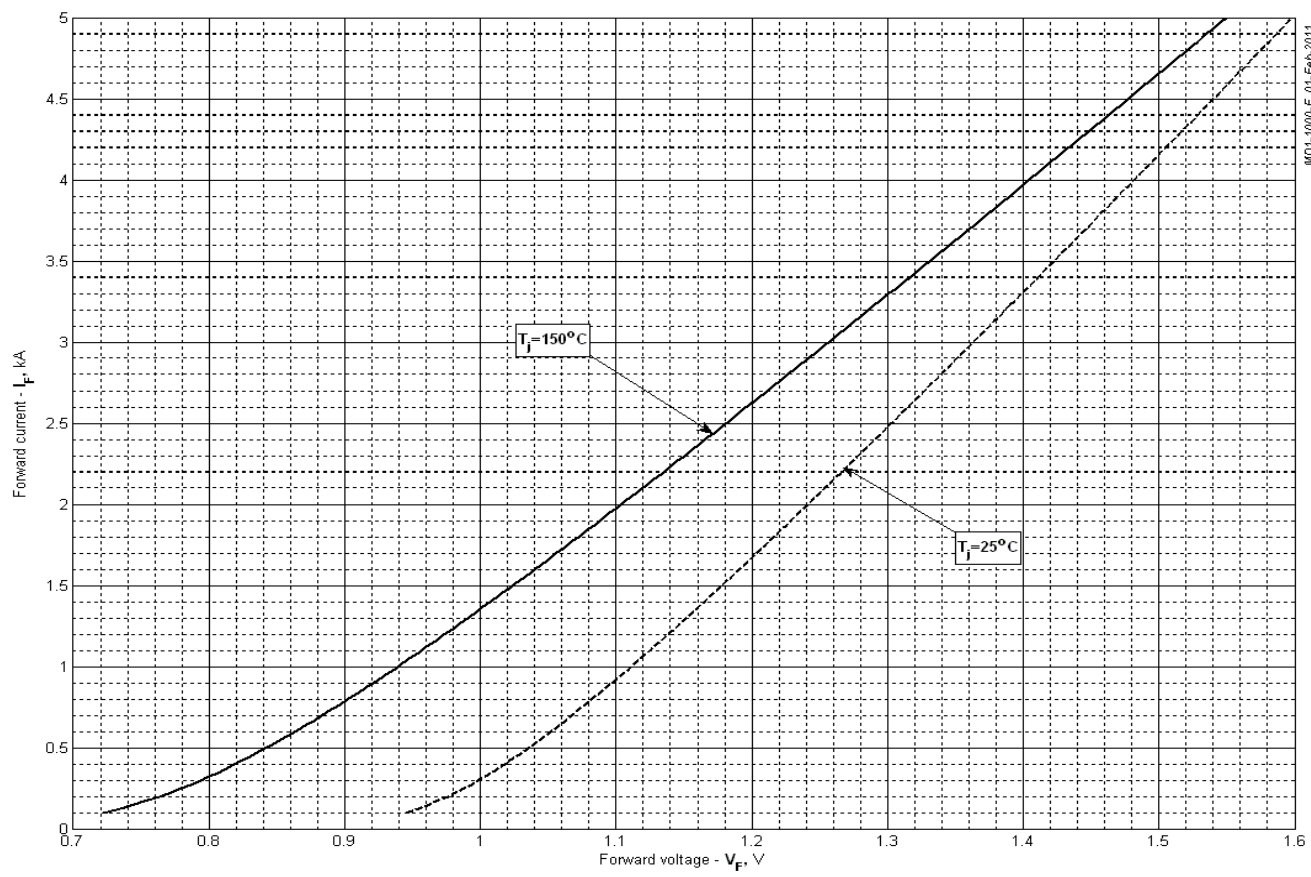


Fig 1 – On-state characteristics of Limit device

Аналитическая функция предельной вольт — амперной характеристики:

$$V_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$$

	Coefficients for max curves	
	T _j = 25°C	T _j = T _{j max}
A	0.867101	0.613247
B	0.080426	0.093879
C	-0.153566	-0.217982
D	0.270074	0.383360

Модель предельной вольт — амперной характеристики (см. Рис. 1).

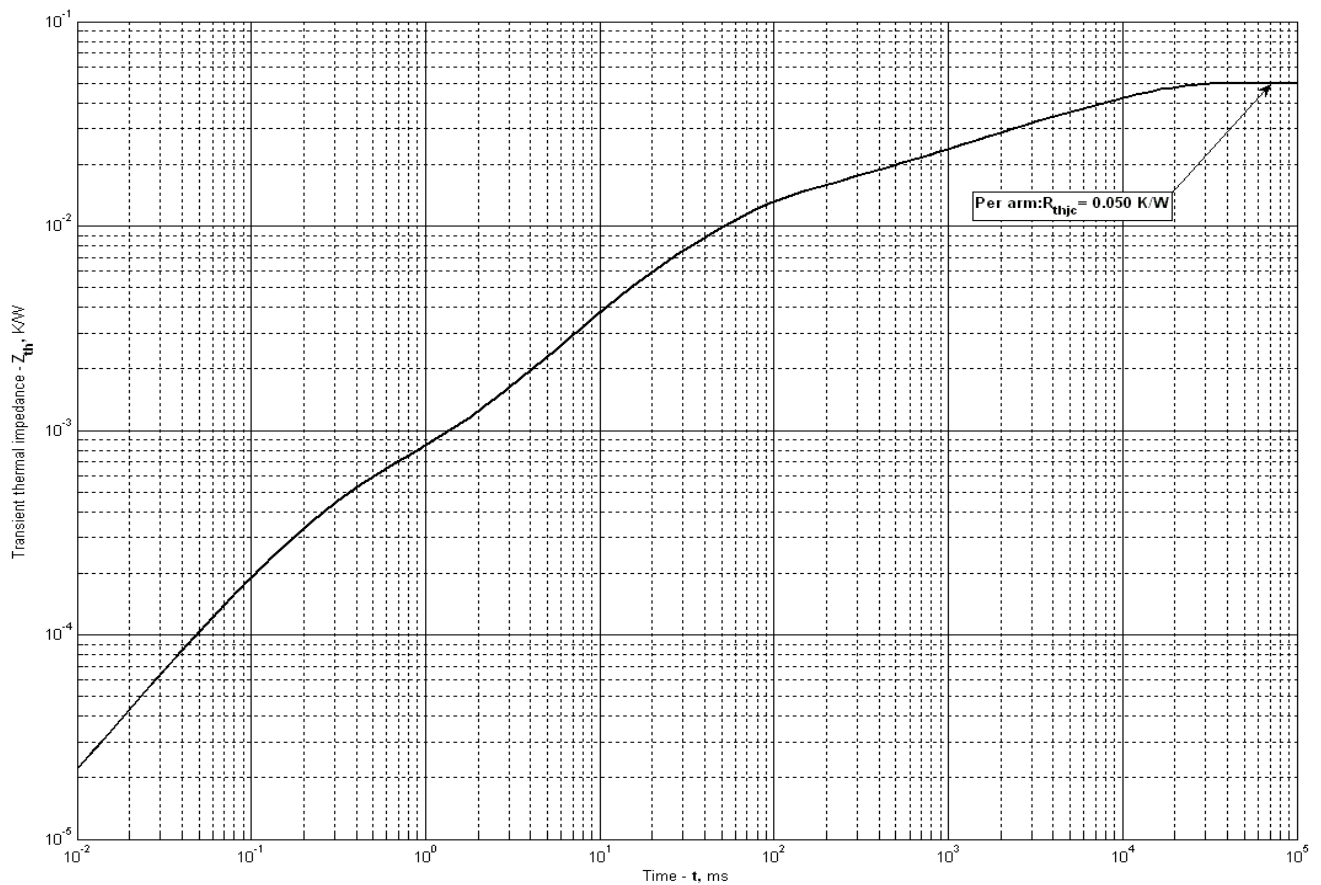


Рис. 2 – Переходное тепловое сопротивление

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где $i = 1$ до n , n – число суммирующихся элементов.

t = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

Z_{thjc} = Тепловое сопротивление за время t .

R_i, τ_i = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

i	1	2	3	4	5	6
$R_i, K/W$	0.02506	0.009643	0.00348	0.009712	0.001719	0.0004399
τ_i, s	8.474	1.110	0.2289	0.04529	0.009524	0.0002414

Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)

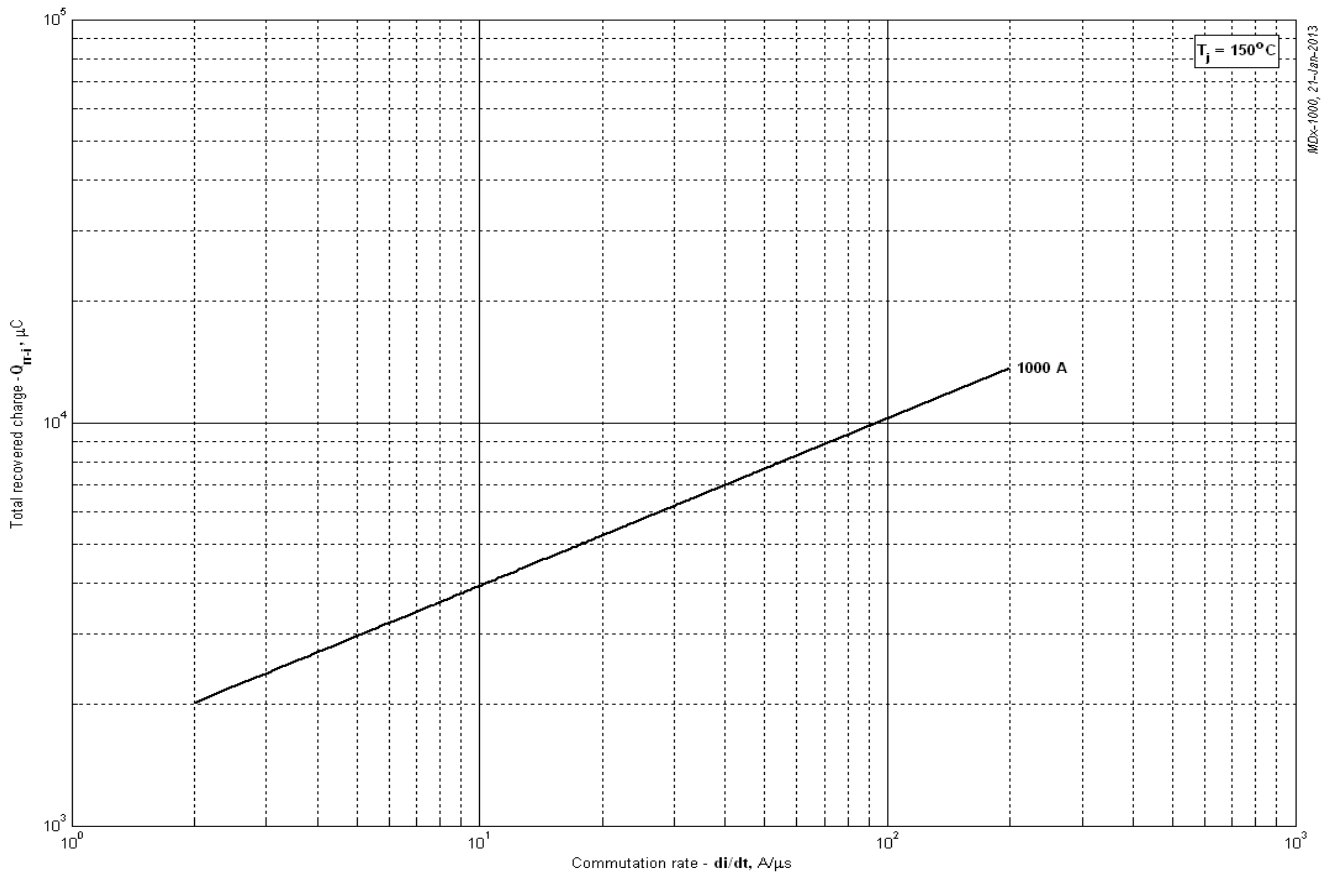


Рис. 3 – Максимальный интегральный заряд обратного восстановления, Q_{rr-i}

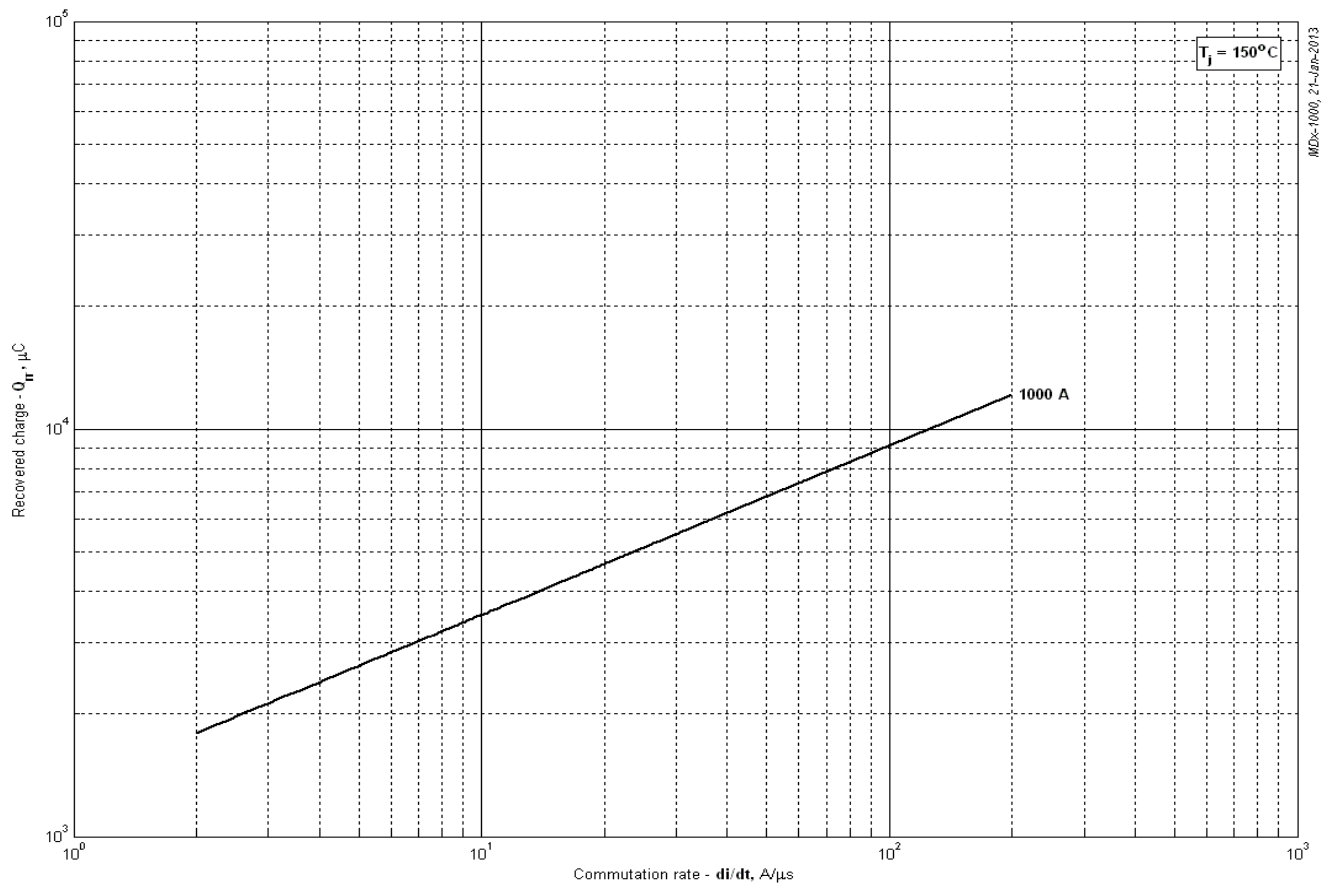


Рис. 4 – Максимальный заряд обратного восстановления, Q_{rr} (по ГОСТ 24461, хорда 25%)

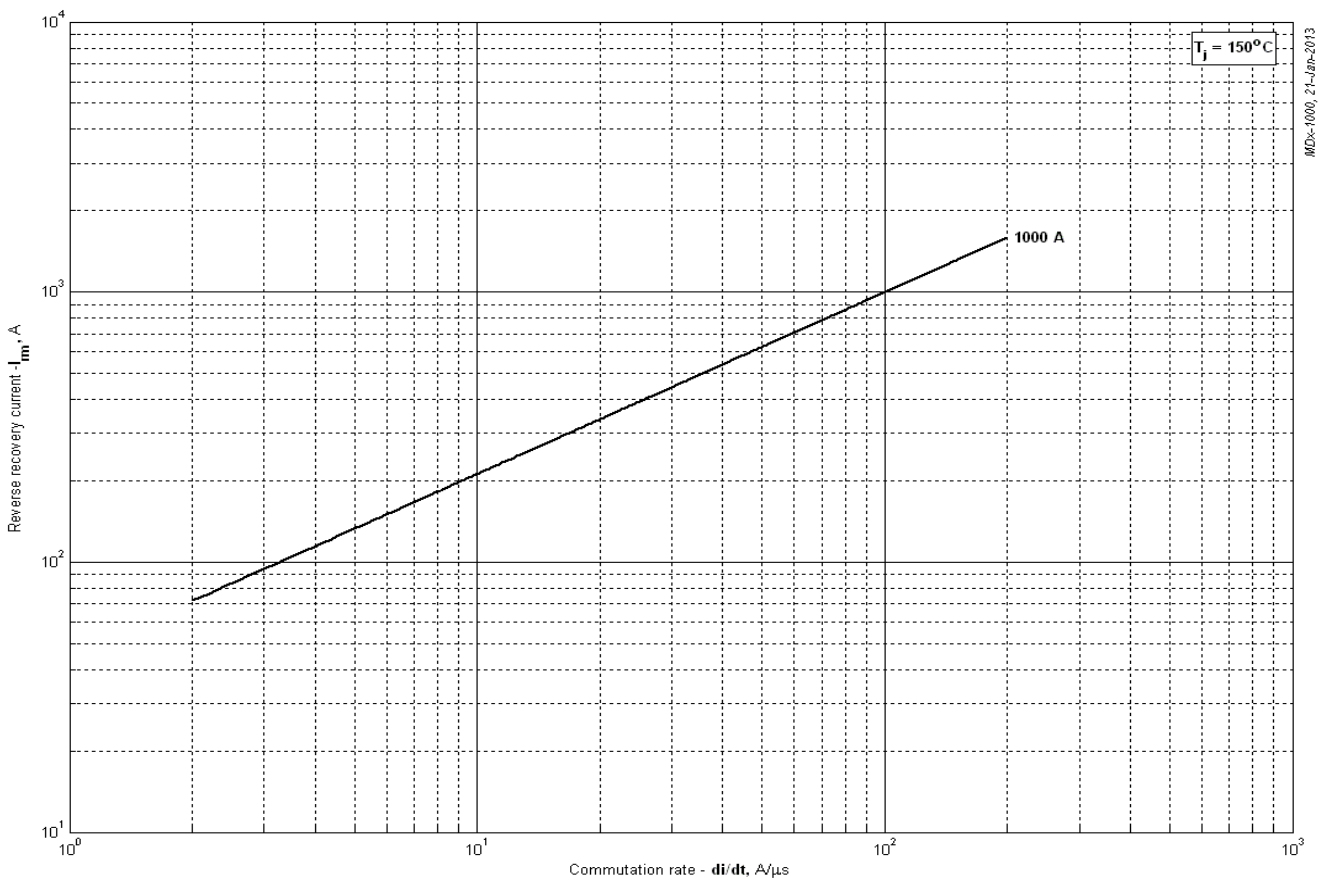


Рис. 5 – Максимальный ток обратного восстановления, I_{rr}

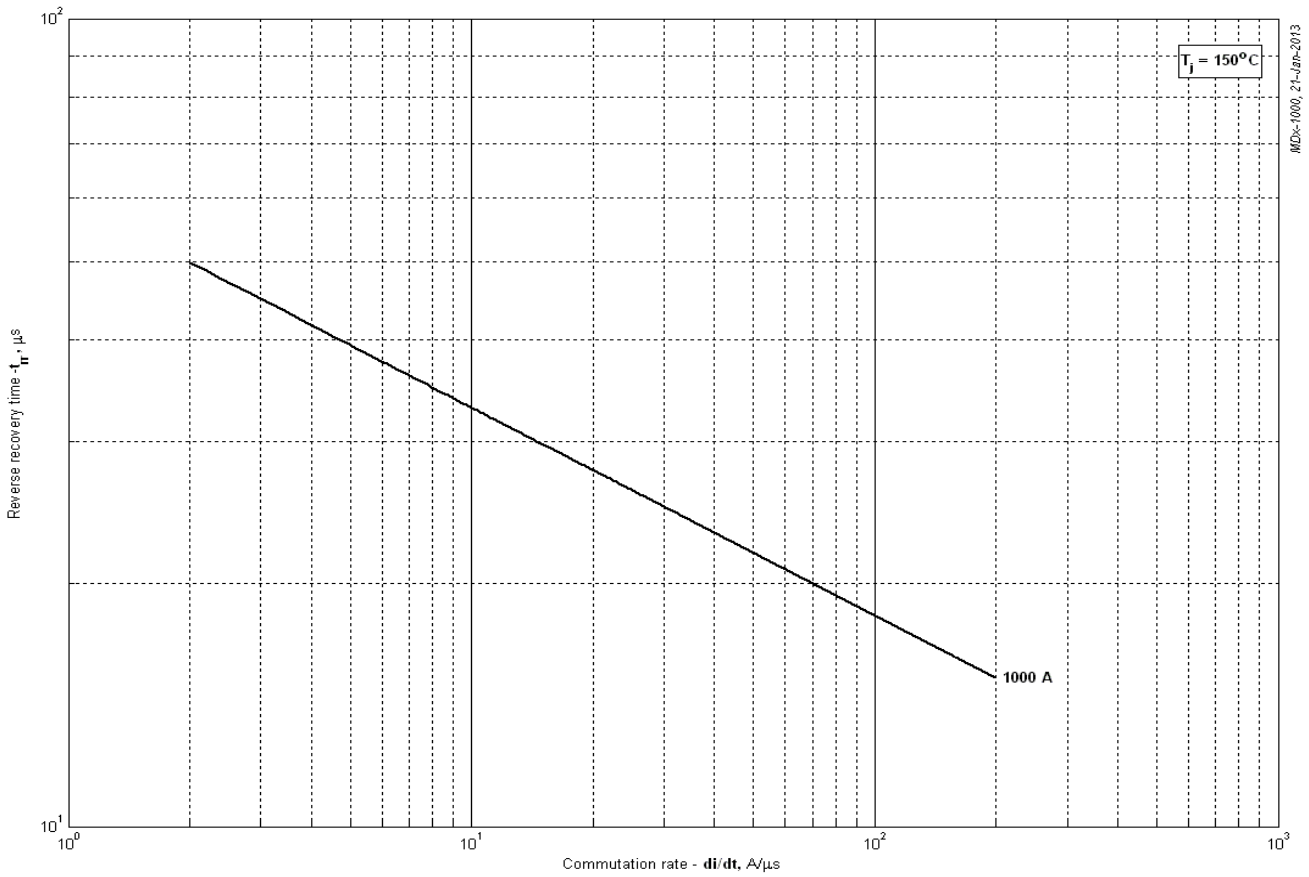
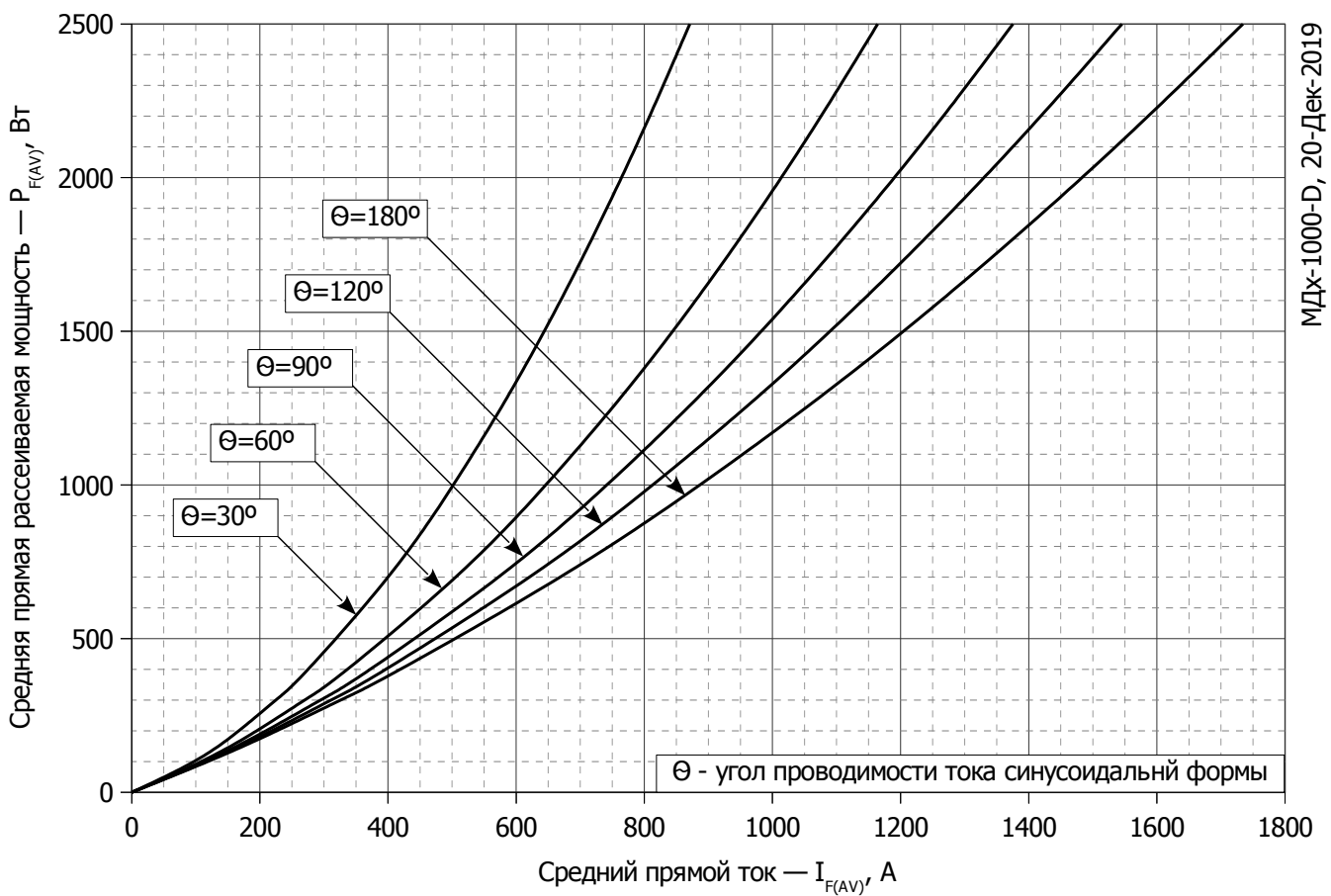
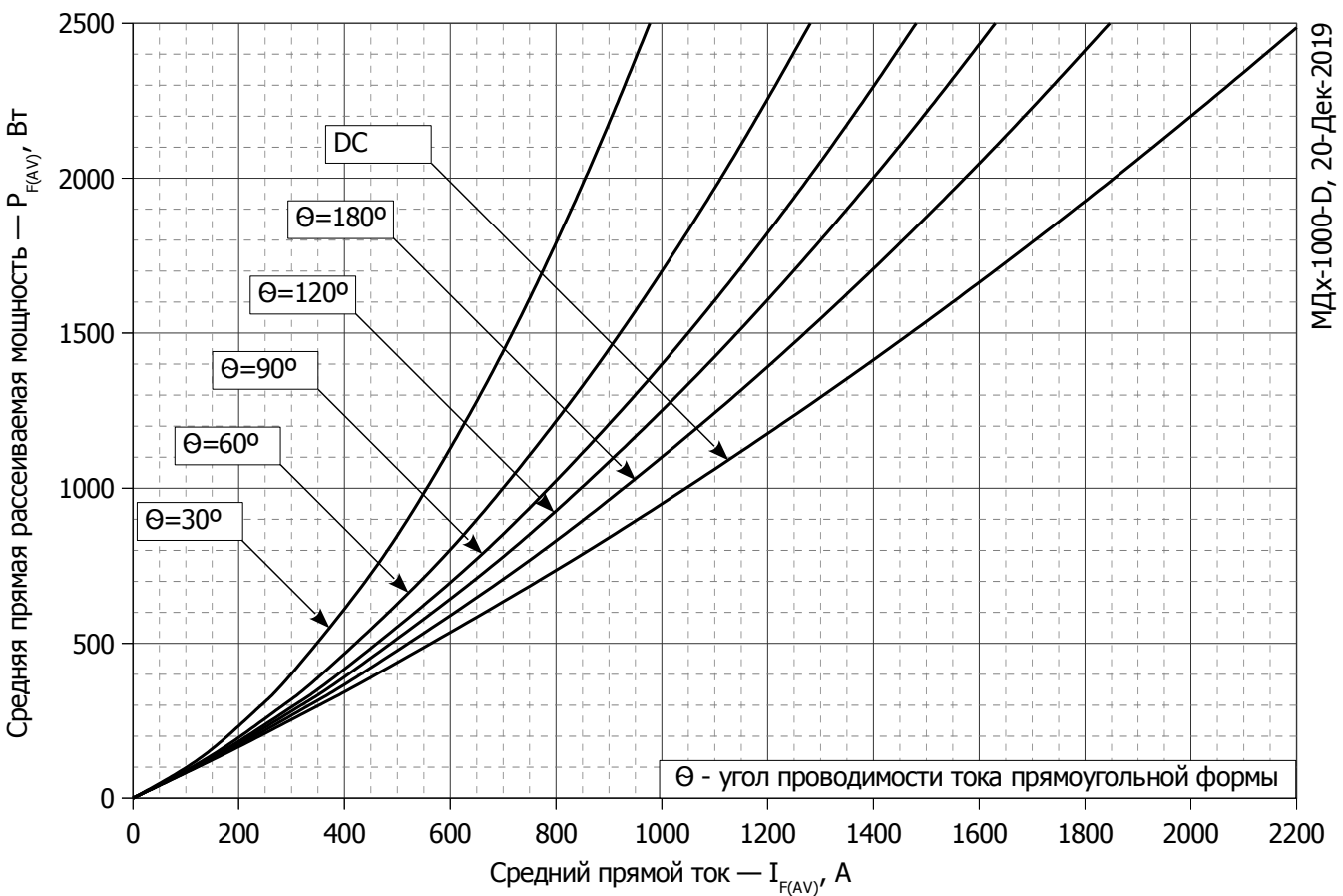


Рис. 6 – Максимальное время обратного восстановления, t_{rr} (по ГОСТ 24461, хорда 25%)



МДх-1000-D, 20-Дек-2019

Рис. 7 – Зависимость потерь мощности P_{FAV} от среднего прямого тока I_{FAV} синусоидальной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)



МДх-1000-D, 20-Дек-2019

Рис. 8 – Зависимость потерь мощности P_{FAV} от среднего прямого тока I_{FAV} прямоугольной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

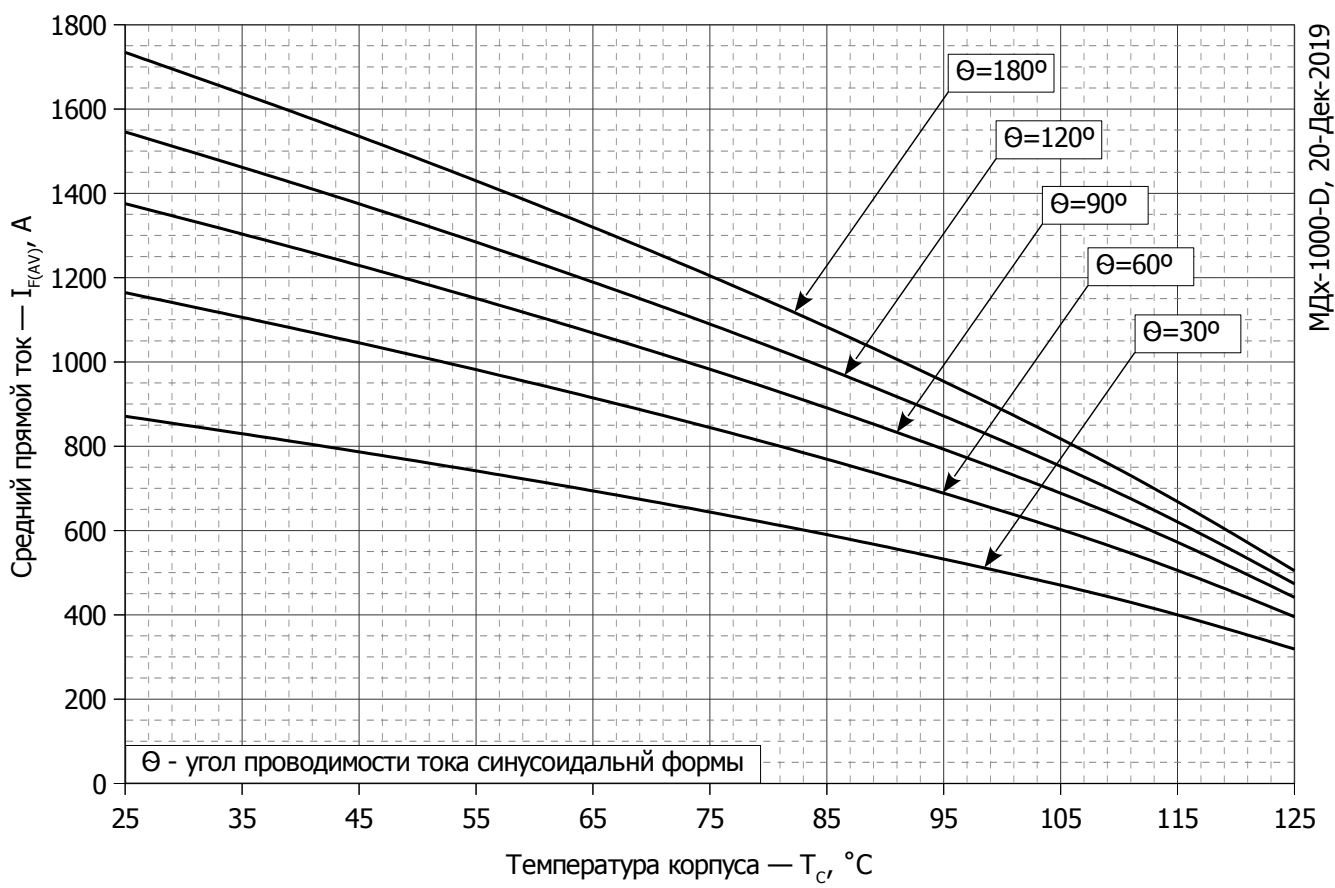


Рис. 9 - Зависимость среднего прямого тока I_{FAV} от температуры корпуса T_c для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

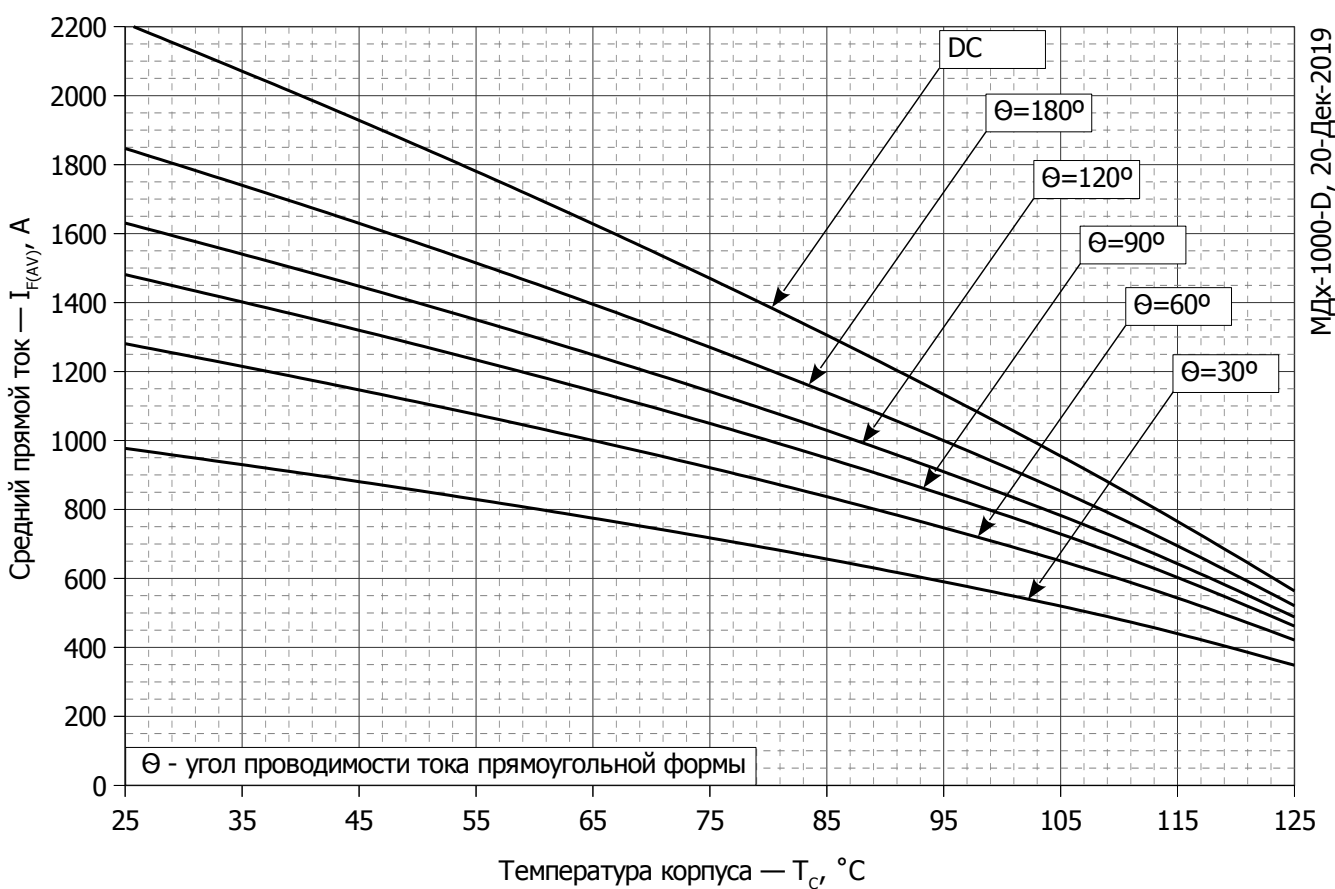


Рис. 10 – Зависимость среднего прямого тока I_{FAV} от температуры корпуса T_c для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

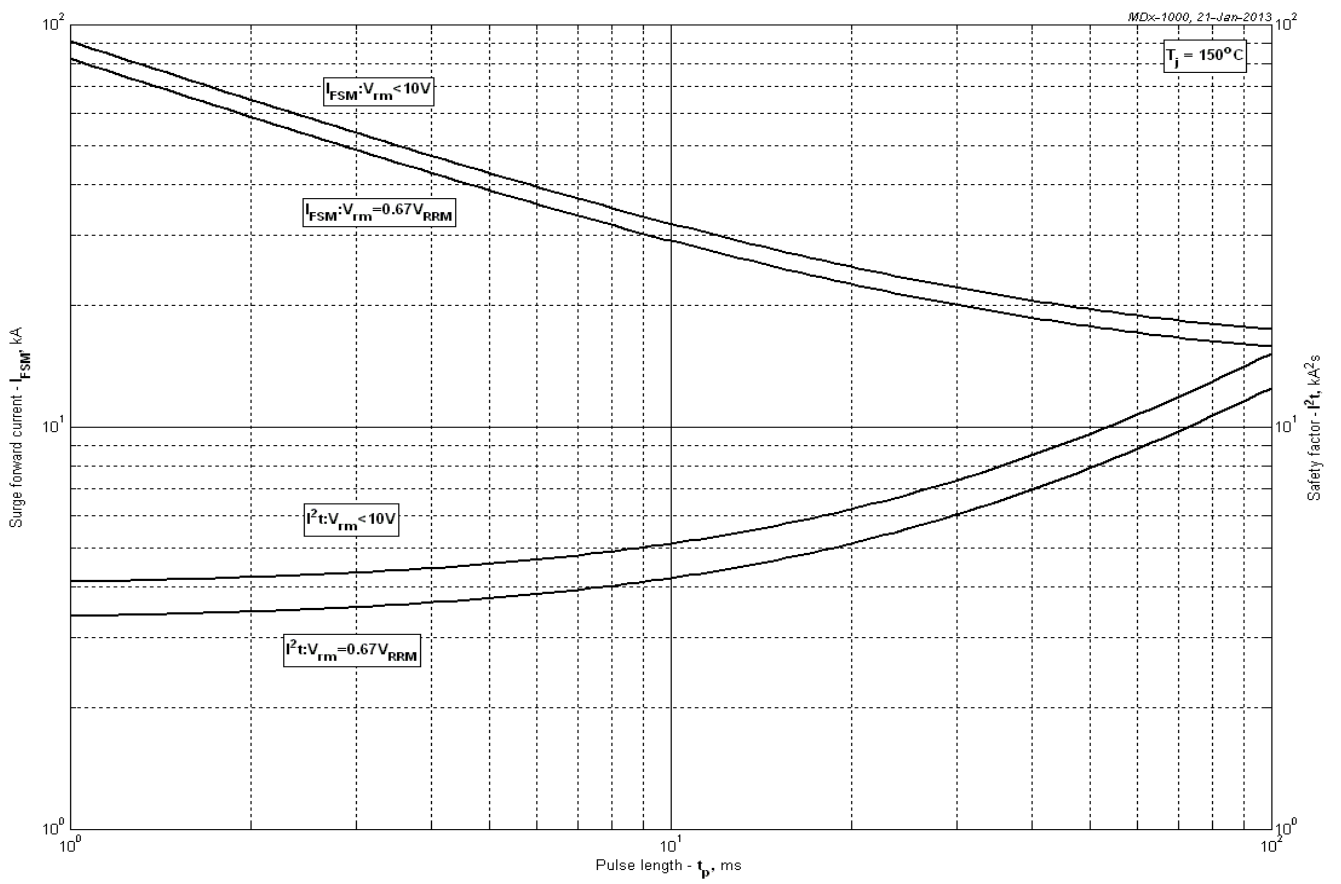


Рис. 11 – Максимальные ударные и I^2t характеристики

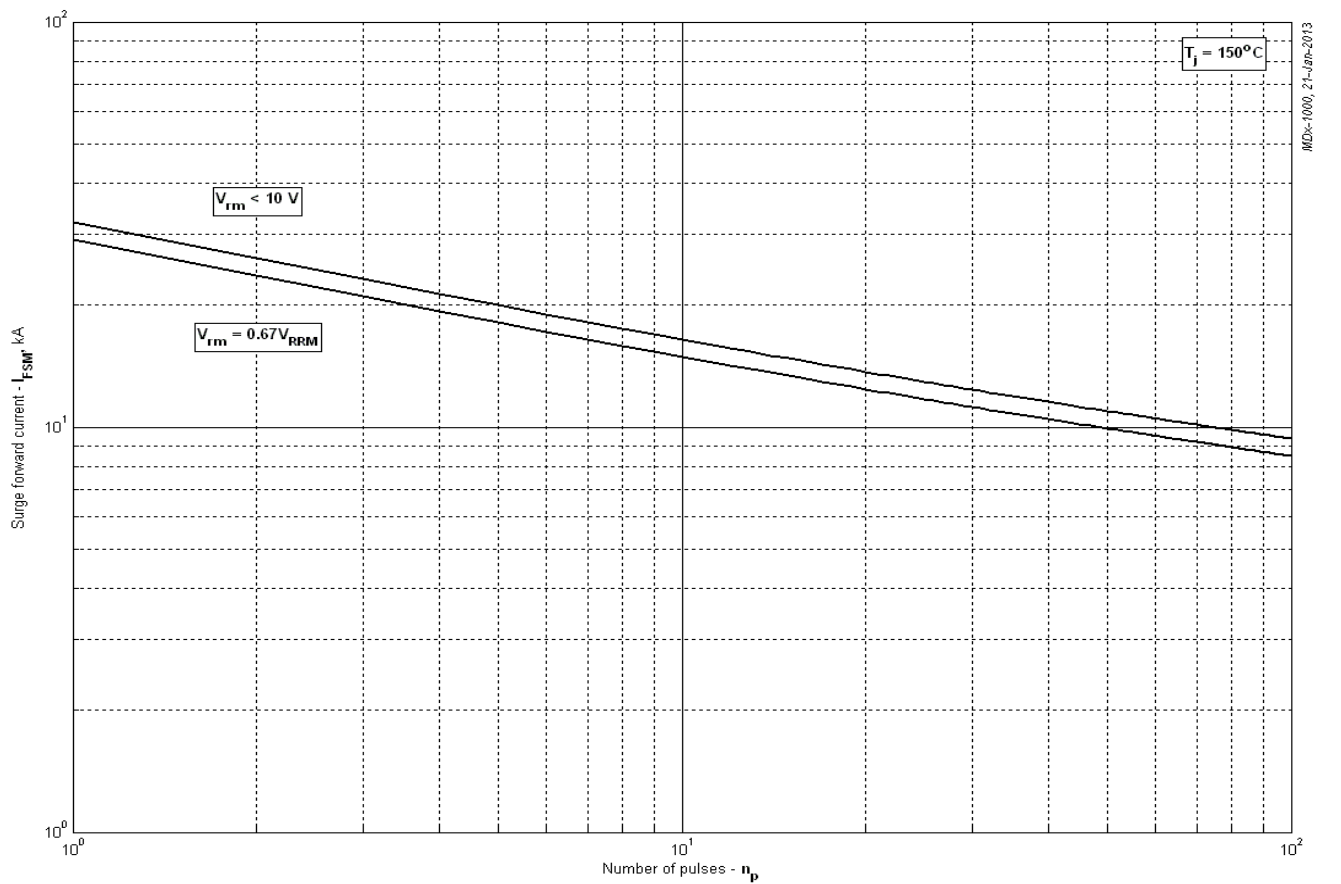


Fig 12 – Максимальные ударные характеристики